













的影响可以忽略不计,而实际系统中阳极整体可放置于一个可高精度控制的三维移动平台上.

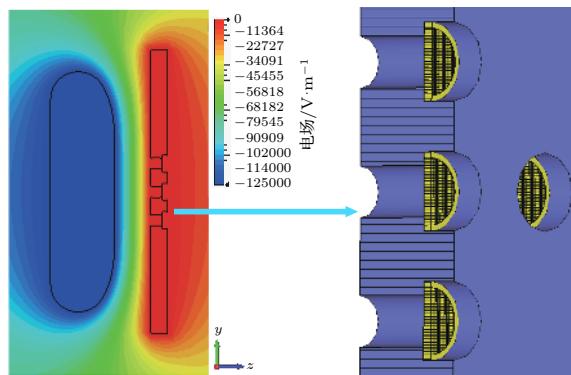


图 8 阳极小孔设计

Fig. 8. Design of anode pinholes.

### 3 时空特性

#### 3.1 系统结构

基于以上均匀场电极和可移动阳极的研究,进一步模拟了超紧凑型 UED 系统在最低 10 kV 和最高 125 kV 加速电压时的电子束特性. 该紧凑型 UED 系统原理如图 9 所示,主要由飞秒激光器、抽运-探测光路、阴阳极、样品托、三维位移台、磁透镜、探测系统等组成. 在新设计中,样品可以放置于两个位置,其一是紧贴着阳极设置,且将磁透镜置于样品之后,从而最大限度地缩短了电子从阴极出射到样品处的行程,使得真空色散和库仑排斥造成的时空展宽最小化,有效提高了时间分辨率,此位置主要是针对低电压情形设计. 由于样品与阴极

距离极短,因此在二者中间不需要磁透镜,简化了系统的调节过程,而且将磁透镜置于样品之后荧光屏之前可用来提高衍射图分辨率. 其二是紧贴磁透镜之后放置,这种设置虽然稍微增加了阴极-样品距离,但是对样品的可操作性更好,而且在较高加速电压下,样品的微小后移对时间分辨率影响不大.

#### 3.2 时空分辨特性

借助粒子轨迹追踪软件 (general particle tracer, GPT)<sup>[22]</sup> 对系统性能进行了表征,利用五阶龙格-库塔法模拟追踪了电子运行轨迹,计算了电子束的时空特性,并且研究了这些性质随主要参数变化的规律. 为了精确模拟空间电荷效应的影响,采用粒子相互作用的 N 体模型模拟了空间电荷效应,该模型下计算时间与粒子数量呈线性关系,计算较快,并且对于小能量弥散的情形十分可靠. 其次,基于输入激光束斑与阴极的光电发射模型,定义了电子源. 实验中采用波长约 266 nm 的紫外激光脉冲,根据阴极的功函数,便可估算初始电子能量弥散. 计算中将会研究不同电子数目下的性能,当电子数目较大时,引入宏粒子以提高计算效率. 因激光脉冲在时间上具有高斯形状,所以电子的初始时间分布也采用高斯分布. 初始发射速度通过相对论参数定义,它们都具有相同的速度,各速度分量均匀地分布在半球上. 电子在空间方向的分布采用与激光束斑分布相同的高斯分布,如图 10 所示为电子源的空间分布,其中包含的电子总数目为 10000,半径为 47 μm (FWHM).

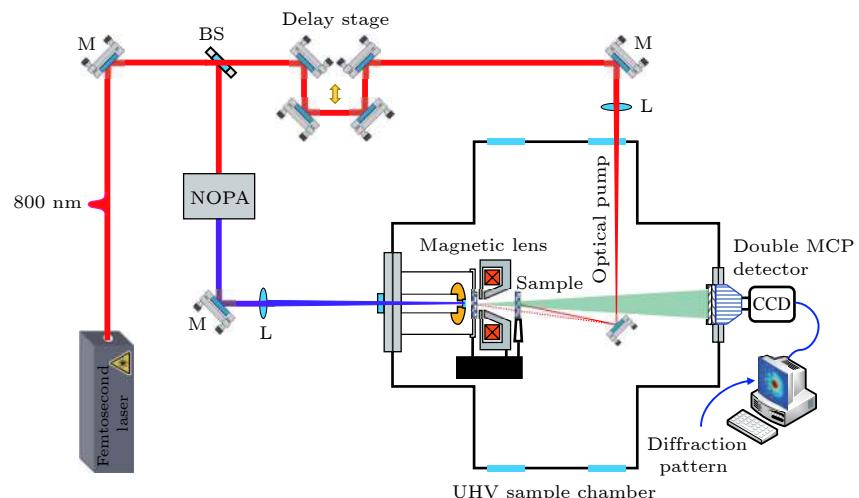


图 9 间距可调型超快电子衍射仪示意图

Fig. 9. Schematic diagram of anode movable ultrafast electron diffractometer.

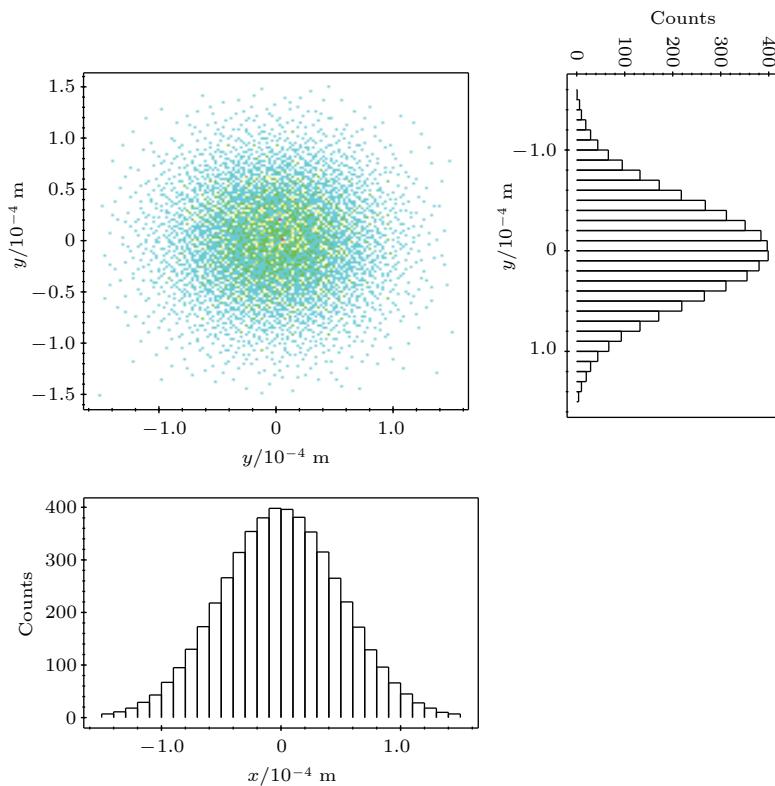


图 10 时间为 0 时电子源的空间分布

Fig. 10. Spatial distribution of electron source at time = 0.

设定了电子源的时间、速度和空间分布之后，便可以模拟电子的运行轨迹，计算系统主要性能参数。为了分析该紧凑型 UED 在不同加速电压、电子初始能量和电子数目下的性能参数，研究了不同参数下的电子脉冲脉宽和束斑尺寸的变化。图 11 所示为不同加速电压  $V$ 、初始能量弥散  $\Delta E$  以及电子数目  $n$  对电子脉宽的影响。其中，图 11(a) 为加速电压为 10 kV 时，初始能量弥散分别为 0.1 和 0.6 eV 以及电子数目为 1000 和 10000 时，电子束长在运行过程中的变化规律。由于在电压为 10 kV 的情况下，阴阳极间距约为 1 mm，因此图 11 中所选范围为  $z = 0$ —5 mm，可以看出在相同初始能量弥散下，电子数目越多，电子脉冲展宽越快，这是受到空间电荷效应的影响，与预期一致。对于相同电子数目，不同初始能量弥散，如  $n = 1000$  时对应的蓝色实线与紫色虚线所示，可以看出小的初始能量弥散在最初有助于电子脉长的减小，但当运行距离逐渐增加时，较大的初始能量弥散更有利于抑制电子脉冲在纵向的快速展宽，同样可以在  $n = 10000$  时得到相同的结论。可见对于较长系统，一味减小初始能量弥散并没有优势。图 11(b) 所示为加速电压为 125 kV 时电子初始能量弥散与电子

数目对电子脉冲长度的影响，类似地，受到空间电荷效应的影响，电子数目越多，电子束纵向展宽越严重。图 11(c) 与图 11(d) 分别对应图 11(a) 和图 11(b)，但具有更大的范围以观察电子运行更远距离后的效果。从图 11(d) 中可明显观察到在电子运行距离较远时，或阴极-样品间距较大时，初始电子能量弥散适当增大反而有利于电子脉冲长度的减小。

图 12 为不同加速电压、初始能量弥散以及电子数目对电子束斑尺寸的影响。分别统计了加速电压为 10, 125 kV，初始能量弥散为 0.1, 0.6 eV，电子数目为 1000, 10000 时的电子束斑尺寸。显然，电子数目越多，束斑尺寸展宽越快，电子初始能量弥散越大，束斑尺寸展宽越快，电子加速电压越小，束斑尺寸展宽越快。

### 3.3 磁聚焦透镜的影响

上面分析了样品紧贴阳极时的情况，但该系统的另一种工作模式便是类似于普通紧凑型 UED，即样品置于磁透镜后的情况。此时，系统一般工作在高电压模式 (125 kV)，在阳极之后、样品之前设置磁透镜以约束电子束的横向发散。图 13 为不同





- Weathersby S 2019 *Nature* **565** 61
- [6] Wolf T J, Sanchez D M, Yang J, Parrish R M, Nunes J P F, Centurion M, Coffee R, Cryan J P, Gühr M, Hegazy K, Kirrander A 2019 *Nat. Chem.* **11** 504
- [7] Mo M, Murphy S, Chen Z, Fossati P, Li R K, Wang Y, Wang X J, Glenzer S 2019 *Sci. Adv.* **5** eaaw0392
- [8] Pei M J, Qi D L, Qi Y P, Jia T Q, Zhang S A, Sun Z R 2015 *Acta Phys. Sin.* **64** 034101 (in Chinese) [裴敏洁, 齐大龙, 齐迎朋, 贾天卿, 张诗按, 孙真荣 2015 物理学报 **64** 034101]
- [9] Luo D, Hui D D, Wen W L, Liu R, Wang X, Tian J S 2017 *Acta Phys. Sin.* **66** 152901 (in Chinese) [罗端, 惠丹丹, 温文龙, 刘蓉, 王兴, 田进寿 2017 物理学报 **66** 152901]
- [10] Gulde M, Schweda S, Streck G, Maiti M, Yu H K, Wodtke A M, Schäfer S, Ropers C 2014 *Science* **345** 200
- [11] Gao M, Lu C, Jean-Ruel H, Liu L C, Marx A, Onda K, Koshihara S, Nakano Y, Shao X F, Hiramatsu T, Saito G, Yamochi H, Cooney R R, Morienna G, Sciani G, Miller R J D 2013 *Nature* **496** 343
- [12] Liu Y Q, Zhang J, Tian J S, Zhao B S, Wu J J, Zhao W 2006 *Acta Phys. Sin.* **55** 3368 (in Chinese) [刘运全, 张杰, 田进寿, 赵宝升, 吴建军, 赵卫 2006 物理学报 **55** 3368]
- [13] Harb M, Ernstorfer R, Hebeisen C T, Sciaim G, Peng W, Dartigalongue T, Eriksson M A, Lagally M G, Kruglik S G, Miller R J D 2008 *Phys. Rev. Lett.* **100** 155504
- [14] Gerbig C, Senftleben A, Morgenstern S, Sarpe C, Baumert T 2015 *New J. Phys.* **17** 043050
- [15] Waldecker L, Bertoni R, Ernstorfer R 2015 *J. Appl. Phys.* **117** 044903
- [16] Sciaim G, Miller R J D 2011 *Rep. Prog. Phys.* **74** 096101
- [17] Liu Y Q, Zhang J, Tian J S, Zhao B S, Wu J J, Zhao W, Hou X 2007 *Acta Phys. Sin.* **56** 123 (in Chinese) [刘运全, 张杰, 田进寿, 赵宝升, 吴建军, 赵卫, 侯洵 2007 物理学报 **56** 123]
- [18] Kassier G H, Haupt K, Erasmus N, Rohwer E G, Schwoerer H 2009 *J. Appl. Phys.* **105** 113111
- [19] Rogowski W 1923 *Die Elektrische Festigkeit am Rande des Plattenkondensators* (Berlin: Springer-Verlag) pp1–15
- [20] Badali D S, Gengler R Y, Miller R J D 2016 *Structural Dynamics-US* **3** 034302
- [21] Bruce F 1947 *J. Inst. Electr. Eng.-Part II; Power Eng.* **94** 138
- [22] van der Geer S <http://www.pulsar.nl/gpt/> [2019.11.23]

